

Авторы благодарят Ж.И. Алфёрова за поддержку работ по РОС-лазерам и Г.М. Гусинского за проведение глубокой имплантации на циклотроне ФТИ.

Список литературы

- [1] А л ф ё р о в Ж.И., К и ж а е в К.Ю., К у ч и н с к и й В.И., К у к с е н к о в Д.В., П о р т н о й Е.Л., С м и р н и ц к и й В.Б. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 9. С. 513-517.
- [2] К и ж а е в К.Ю., К у к с е н к о в Д.В., К у ч и н с к и й В.И., Н и к и т и н С.А., П о р т н о й Е.Л., С м и р н и ц к и й В.Б. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 3. С. 267-273.
- [3] Г у р и е в А.И., К у к с е н к о в Д.В., К у ч и н с к и й В.И., Н и к и т и н С.А., П о р т н о й Е.Л., С м и р н и ц к и й В.Б. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 12. С. 1082-1088.
- [4] O g i t a S., Y a n o M., I s h i k a w a H., I w a i H. // Electr. Lett. 1987. V. 23. N 8. P. 393-394.
- [5] Б а р ы ш е в В.И., Г о л и к о в а Е.Г., Д у р а е в В.П., К у ч и н с к и й В.И., К и ж а е в К.Ю., К у к с е н к о в Д.В., П о р т н о й Е.Л., С м и р н и ц к и й В.Б. // Квантовая электроника. 1988. Т. 15. № 11. С. 2196-2198.
- [6] S a k a i K., U t a k a K., A k i b a S., M a t s u s h i m a Y. // IEEE J. of Quant. Electr. 1982. V. QE-18. N 8. P. 1272-1278.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе АН СССР,
Ленинград

Поступило в Редакцию
5 июля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 17
05.3; 10· 11

12 сентября 1989 г.

НЕТЕПЛОВЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ЭФФЕКТЫ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ СПЛАВОВ УСКОРЕННЫМИ ИОНАМИ

С.Н. Б о р о д и н, Ю.Е. К р е й и д е л ь,
Г.А. М е с я ц, В.В. О в ч и н и к о в,
В.А. Ш а б а ш о в

Известно [1, 2], что ионная бомбардировка приводит к изменению физических свойств приповерхностных слоев металлических сплавов. При этом глубина модифицированной зоны во многих случаях существенно превышает пробеги бомбардирующих частиц. Передача энергии ионного воздействия в модифицируемом слое при типичных для

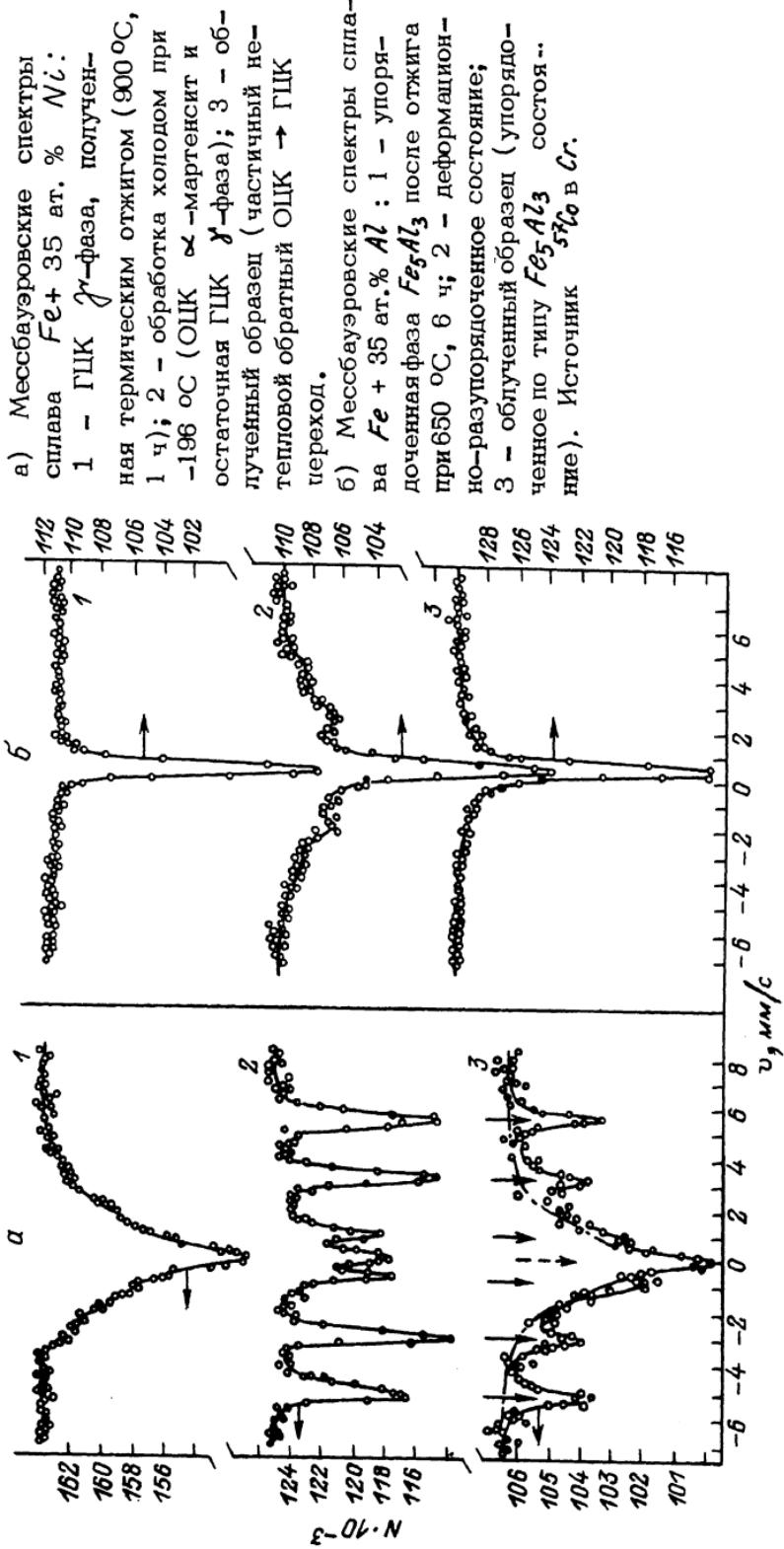
сплавов дозах облучения должна осуществляться с участием подавляющей части атомов этого слоя. Однако до настоящего времени не обнаружено протекания каких-либо глобальных перестроек кристаллической решетки под воздействием ионной бомбардировки на глубине, многократно превышающей пробеги ионов. Имеются лишь данные об изменении дислокационной структуры исходной матрицы [2].

В большинстве работ по ионной модификации объектами воздействия являлись либо химически чистые вещества, либо конструкционные материалы. В первом случае атомы неразличимы и соответственно, картина возможных атомных перестроек и структурных превращений достаточно бедна. Во втором, напротив, в силу сложности состава и многофазности изучаемых систем затруднено выделение роли различных факторов ионного воздействия. В связи с этим ряд эффектов, имеющих место при ионной бомбардировке, может быть более отчетливо выявлен при использовании достаточно простых модельных материалов с сильной зависимостью свойств от структуры.

В работе исследовалось воздействие пучка ионов азота с энергией $E = 20$ кэВ и плотностью тока $j = 50$ мкА/см² в вакууме ($P = 5 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.) на сплав $Fe + 30.5$ ат.% Ni , имеющий после обработки холодом (-196 °C) структуру ОЦК α -мартенсита с небольшим количеством ~ 5 % остаточной ГЦК γ' -фазы, а также на деформационно-разупорядоченный прокаткой при комнатной температуре упорядочивающийся по типу A_5B_3 ¹ сплав $Fe + 35$ ат.% Ni . Расчетная величина плотности мощности ионного пучка $P_s = jE/e$ (~ 1 Вт/см²) совпадала с ее оценкой из измерений скорости нагрева изолированного массивного медного цилиндра с учетом достаточно малых поправок на излучение. Длительность воздействия $t \approx 2$ с подбиралась таким образом, чтобы предельный нагрев ΔT образцов даже при полном отсутствии отвода тепла как теплопроводностью, так и излучением не превышал 200 К. Это соответствовало дозе $D \approx 6 \cdot 10^{14}$ см⁻², что значительно меньше типичных доз ~ (1-5) × 10¹⁷ см⁻², используемых при имплантации в металлы. В условиях эксперимента фольги из указанных материалов толщиной 30 мкм контактировали с поверхностью дюралюминиевого стола, что обеспечивало достаточно интенсивный теплоотвод. Для контроля предельной величины нагрева облучавшихся образцов на них помещались мелкие (толщиной 30 мкм) частички сплава ПОС-61, имеющего температуру плавления 190 °C. Оплавление этих частичек в результате облучения не наблюдалось.

Источником ионов азота служил электронно-ионный источник на основе тлеющего отражательного разряда с полым катодом [3], работающий в режиме генерации ионного пучка. Исследование сплавов осуществлялось методами ядерного гамма-резонанса и рентгеноструктурного анализа на установках ЯГРС-4 и ДРОН-3.

¹ Упорядоченная структура 3-го ранга, получающаяся из В2 структуры в результате выделения дополнительных подрешеток с разной заселенностью.



На основании результатов анализа мессбауэровских спектров (см. рисунок) и данных рентгеноструктурных исследований установлено, что при облучении исследуемых материалов указанной моли дозой и при отсутствии разогрева, достаточного для протекания термических превращений, происходит существенная перестройка их кристаллической и магнитной структуры. Так, около 60 % объема образца сплава $Fe + 30.5$ ат.% Ni претерпевает обратное $\alpha \rightarrow \gamma$ (ОЦК \rightarrow ГЦК) превращение, которое при нагреве начинается лишь при 500 $^{\circ}C$ и заканчивается при 650 $^{\circ}C$. Следует подчеркнуть, что даже в пересчете на превращенный объем образца подведенной энергии недостаточно для достижения этим объемом температуры начала термического перехода. Сплав $Fe + 35$ ат.% Al при облучении в тех же условиях за $\tau \approx 2$ с переходит из деформационно-разупорядоченного в упорядоченное по типу B2 состояние. В этом сплаве превращение завершается на 100 % по всей глубине образца, что полностью исключает из числа возможных причин превращения неоднородность поля температур по глубине образца (при усредненной оценке без учета теплоотвода $\Delta T \geq 200$ К). Помещение деформационно-разупорядоченного сплава в масляную ванну с температурой нагрева 220 $^{\circ}C$ на несколько десятков секунд не вызывает его превращения в упорядоченное состояние, что однозначно свидетельствует о нетепловой природе индуцируемого ионным облучением фазового перехода.

Было установлено, что существует минимальное значение плотности ионного тока, вызывающее обнаруженные превращения. Так, например, при уменьшении плотности ионного тока до $j = 20$ мкА/см² описанные превращения не происходят даже при достаточно длительном облучении (до $D = 5 \cdot 10^{17}$ см⁻²).

Структурные перестройки приводят к изменению магнитных свойств исследованных сплавов. Сплав $Fe_{65}Al_{35}$, вследствие уменьшения числа положительных обменных связей $Fe-Fe$ при ионном облучении переходит из ферро- в парамагнитное состояние. Ферромагнитные свойства железо-никелевого сплава при $\alpha \rightarrow \gamma$ переходе значительно ослабляются ($T_c^{\alpha} \approx 500$ $^{\circ}C$, $T_c^{\gamma} = 68$ $^{\circ}C$).

Обнаруженные переходы, не являющиеся результатом прямого радиационного или теплового воздействия, могут быть связаны с возникновением ударных волн при эволюции каскадов атомных столкновений [3, 4]. Согласно [3], ударные волны распадаются на неупругие и непрерывные упругие уединенные волны. Можно предположить, что солитоноподобные волны с высокой запасенной плотностью энергии в определенных условиях способны играть роль инициирующего фактора, вызывающего превращение всего объема кристалла. При экзотермическом характере процесса уединенные волны могут стать незатухающими, а индуцированные ионной бомбардировкой или другим подобным импульсным воздействием фазовые превращения – самораспространяющимися.

С п и с о к п и т е р а т у р ы

- [1] Модифицирование и легирование поверхности лазерными, ионными и электронными пучками / Под ред. Дж. Поута и др.; Пер. с англ. Н.К. Мышкина и др. / Под ред. А.А. Углова. М.: Машиностроение. 1987. С. 424.
- [2] Диценко А.Н., Лигачев А.Е., Куракин И.Б. Воздействие пучков заряженных частиц на поверхность металлов и сплавов. М.: Атомиздат. 1987. 184 с.
- [3] Крейндель Ю.Е. В сб.: Разработка и применение источников интенсивных электронных пучков. Новосибирск: Наука, 1976.
- [4] Жуков В.П., Демидов А.В. // Атомная энергия. 1985. Т. 59. В. 1. С. 29–33.
- [5] Жуков В.П., Болдин А.А. // Атомная энергия. 1987. Т. 63. В. 6. С. 375–379.

Поступило в Редакцию
22 июня 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 17

12 сентября 1989 г.

06.2

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ МЕТОД ПЕРЕНОСА НА ПОЛУПРОВОДНИКОВУЮ ПЛАСТИНУ РИСУНКА ТРАФАРЕТНОГО ШАБЛОНА С ЭЛЕМЕНТАМИ РАЗМЕРОМ ~ 0.1 МКМ

К.А. Валиев, Л.В. Великов,
Р.Х. Махмутов, С.Н. Сидорук,
В.С. Якунин

При разработке электронных сверхвысокочастотных приборов геометрические размеры элементов структуры приборов вплотную приблизились к значению 0.1 мкм [1]. В литографии подобная разрешающая способность достигается с помощью электронно-лучевых систем с нанометровым диаметром пучка, например при формировании рисунка на тонких мембранных [2]. Эти же системы могут использоваться и для изготовления образцов приборов с размерами элементов ≤ 0.1 мкм путем экспонирования пленок резистов непосредственно на полупроводниковой пластине [3]. Однако промышленная технология изготовления приборов требует разработки методов параллельного переноса изображения шаблонов с размерами элементов ≤ 0.1 мкм. Таким методом может быть метод электронно-лучевого переноса в широких пучках рисунка трафаретного шаблона на полупроводниковую пластину.